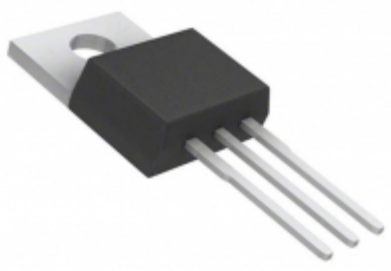




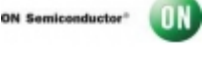



	<h2 style="color: red;">FDP032N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP032N08</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP032N08.pdf 2.FDP032N08.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25733 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP032N08
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25733 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15160pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP032N08 ist neu im Original, Suche FDP032N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP032N08 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP032N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP032N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3	 FDP032N08 FDK America MOSFET N-CH 75V 120A TO-220	 FDP032N06 Fairchild/ON Semiconductor FDP032N06 FAIRCHILD	 FDP030N06BTU Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06BTU FAIRCHILD
 FDP032N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A TO220	 FDP036N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3	 FDP032N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3	 FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP020N06B	↔ FDP023N08B	⇒ FDP025N06	D FDP025N06	⇒ FDP027N08B
⊣ FDP027N08B	⊗ FDP030N06	D FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102	⇒ FDP032N08
⊗ FDP032N08B	⊣ FDP036N10A	⊗ FDP036N10A	↔ FDP038AN06A0	⇒ FDP038AN06A0
D FDP038AN06A0	⊗ FDP039N08B	⊣ FDP040N06	⊗ FDP040N06	⇒ FDP045N10A
⇒ FDP045N10A	↔ FDP047AN08	⊗ FDP047AN08A0	⊣ FDP047AN08A0	⇒ FDP047AN08A0
↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08	D FDP047N08AO	⊗ FDP047N10	⊣ FDP047N10
⊗ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06A0	↔ FDP053N08B	⇒ FDP053N08B_F102
⊣ FDP054N10	⊗ FDP054N10	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0
⊗ FDP060N08A0	⊣ FDP060N08AO	⊗ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06A0
↔ FDP070AN06A0	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊗ FDP083N15A	⇒ FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited